

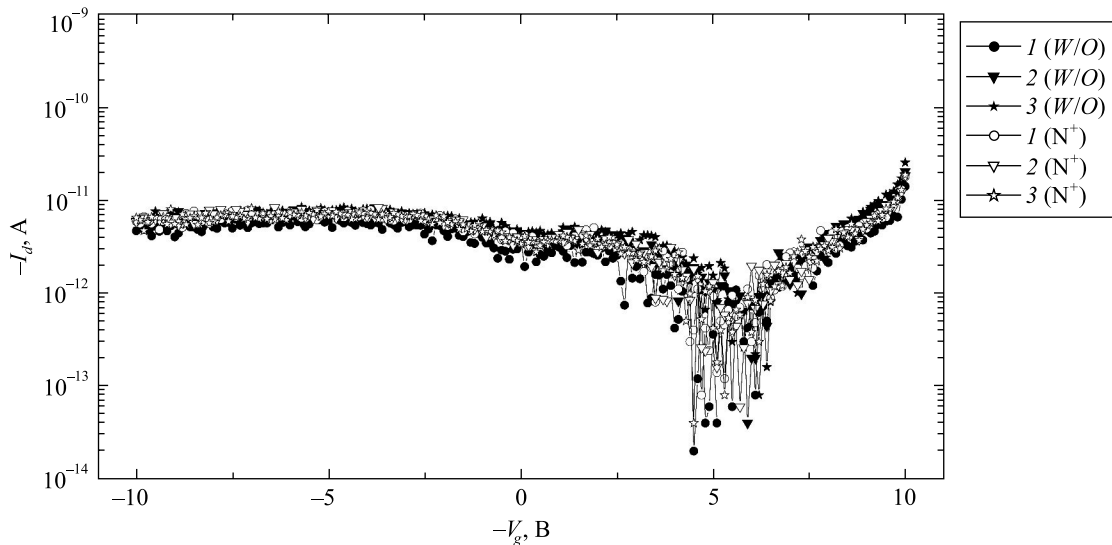


Рис. 1. Зависимости тока утечки затвора (I_d) от напряжения на затворе (V_g) для контрольных (W/O) и имплантированных (N⁺) образцов при прямом порядке БТО ($D_{N^+} = 2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-2}$, $E = 40 \text{ кэВ}$).

Номера кривых соответствуют трем разным приборам, изготовленным на одной пластине

Fig. 1. Dependences of gate leakage current (I_d) on gate voltage (V_g) for control (W/O) and implanted (N⁺) samples at forward order of rapid thermal annealing ($D_{N^+} = 2 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-2}$, $E = 40 \text{ keV}$).

Curve numbers correspond to three different devices made on the same wafer